

7732 『ワイドギャップ半導体 光・電子デバイス』 / 正誤表

・以下のページに誤りがございました。訂正するとともにお詫び申し上げます。

(第1版第1刷用)

頁・行	誤	正
p.xvi, 文献4	et al.	and M. Hashimoto
(同上)	赤崎勇	赤崎勇
p.xvi, 文献6	et al.	, E. A. Miller and J. E. Berkeyheiser
(同上)	Review	Rev.
p.xvi, 文献8	赤崎勇	赤崎勇
p.xvi, 文献9	et al.	, Y. Toyoda, H. Kobayasi and I. Akasaki
p.xvi, 文献10	et al.	, N. Sawaki, I. Akasaki and Y. Toyoda
p.xvi, 文献11	et al.	, H. Amano, Y. Koide, K. Hiramatsu and N. Sawaki
p.xvi, 文献12	et al.	, I. Akasaki, T.Kozawa, K. Hiramatsu, N. Sawaki, K. Ikeda and Y. Ishii
p.xvi, 文献13	et al.	, M. Kito, K. Hiramatsu and I. Akasaki
p.xvi, 文献14	et al.	, M. Kito, K. Hiramatsu and I. Akasaki
p.9, 15行目	505 ~ 510	405 ~ 410
p.16, 5行目	生かし切った	生かした
p.24, 下から2行目 他すべて同	ドレーン	ドレイン
p.37, 7行目	構造と考えると,	構造と考え,
p.38, 表2.1中の左下 端枠内	(伝導帯最下端の運動量)	削除
p.49, 下から8行目	Q_c	θ_c
p.85, 表2.8の8行目	a 3.8192 b 5.815	a 3.1892 b 5.185
p.264, 下から7行目	FRD	ファーストリカバリダイオード(FRD)
p.265, 下から4行目	BJT	バイポーラジャンクショントランジスタ(BJT)
p.269, 図4.30	レンセリール	レンセラール
p.308, 5行目	SiC単晶	SiC単結晶
p.319, 下から2行目	半地幅	半値幅
p.331, 18行目	固化剤	鉍化剤
p.348, 下から1行目	模式的に示した ⁵⁰⁾ .	模式的に示した ⁴⁰⁾ .
p.380, 図5.72	$-(4.96 \pm 0.28) \times (1 - x)$	$-(4.96 \pm 0.28) x (1 - x)$
p.380, 下から1行目	引っ張り	圧縮
p.382, 3行目	供給量を極めて少しずつ	供給速度をパラメータとし, 表面被覆率を